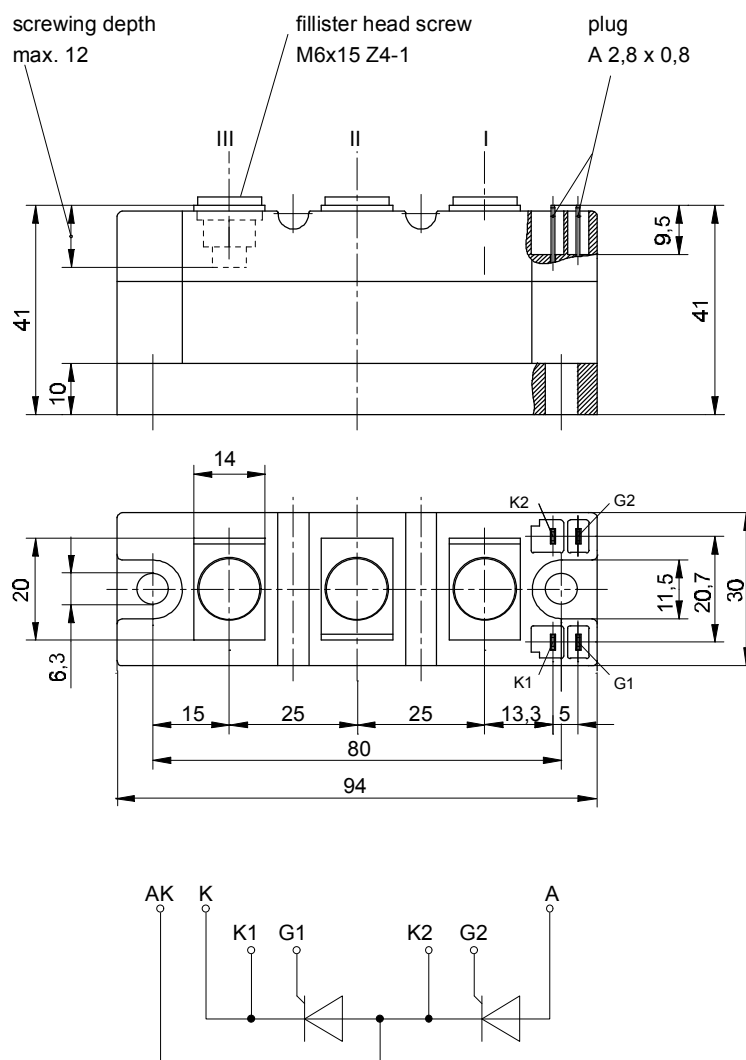




European Power-Semiconductor and Electronics Company

# Marketing Information

## TT 101 F



# TT 101 F, TD 101 F, DT 101 F

Elektrische Eigenschaften	Electrical properties				
Höchstzulässige Werte	Maximum rated values				
Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung	repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \text{ max}}$	$V_{\text{DRM}} V_{\text{RRM}}$	800 1000 1100 1200 1300 1400	V
Vorwärts-Stoßspitzensperrspannung	non-repetitive peak forward off-state voltage	$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \text{ max}}$	$V_{\text{DSM}} = V_{\text{DRM}}$		
Rückwärts-Stoßspitzensperrspannung	non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \text{ max}}$	$V_{\text{RSM}} = V_{\text{RRM}}$	+ 100	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS on-state current	$t_c = 85^{\circ}\text{C}$	$I_{\text{TRMSM}}$	200	A
Dauergrenzstrom	average on-state current	$t_c = 70^{\circ}\text{C}$	$I_{\text{TAVM}}$	101 128	A
Stoßstrom-Grenzwert	surge current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I_{\text{TSM}}$	2750	A
Grenzlastintegral	$\int i^2 dt$ -value	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, t_p = 10 \text{ ms}$	$\int i^2 dt$	2400	A
		$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$		37800	A <sup>2</sup> s
		$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, t_p = 10 \text{ ms}$		28800	A <sup>2</sup> s
Kritische Stromsteilheit	critical rate of rise of on-state current	$V_D \leq 67\%, V_{\text{DRM}}, f_o = 50 \text{ Hz}$ $I_{\text{GM}} = 0,6 \text{ A}, di_G/dt = 0,6 \text{ A}/\mu\text{s}$	$(di/dt)_{\text{cr}}$	160	A/ $\mu\text{s}$
Kritische Spannungssteilheit	critical rate of rise of off-state voltage	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, V_D = 0,67 V_{\text{DRM}}$ 6.Kennbuchstabe/6th letter B 6.Kennbuchstabe/6th letter C 6.Kennbuchstabe/6th letter L 6.Kennbuchstabe/6th letter M	$(dv/dt)_{\text{cr}}$	1) 50	2) 50
				500	500
				500	50
				1000	500
					V/ $\mu\text{s}$ V/ $\mu\text{s}$ V/ $\mu\text{s}$ V/ $\mu\text{s}$
<b>Charakteristische Werte</b>		<b>Characteristic values</b>			
Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, I_T = 350 \text{ A}$	$V_T$	max. 2,15	V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$	$V_{\text{T(TO)}}$	1,2	V
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$	$r_T$	2,1	m $\Omega$
Zündstrom	gate trigger current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$	$I_{\text{GT}}$	max. 150	mA
Zündspannung	gate trigger voltage	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$	$V_{\text{GT}}$	max. 2	V
Nicht zündender Steuerstrom	gate non-trigger current	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, V_D = 6 \text{ V}$	$I_{\text{GD}}$	max. 10	mA
Nicht zündende Steuerspannung	gate non-trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, V_D = 0,5 V_{\text{DRM}}$	$V_{\text{GD}}$	max. 0,25	V
Haltestrom	holding current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_A = 10 \Omega$	$I_{\text{H}}$	max. 250	mA
Einraststrom	latching current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_{\text{GK}} \geq 20 \Omega$ $I_{\text{GM}} = 0,6 \text{ A}, di_G/dt = 0,6 \text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 10 \mu\text{s}$	$I_{\text{L}}$	max. 1	A
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom	forward off-state and reverse currents	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, V_D = V_{\text{DRM}}, V_R = V_{\text{RRM}}$	$i_D, i_R$	max. 30	mA
Zündverzug	gate controlled delay time	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, I_{\text{GM}} = 0,6 \text{ A}, di_G/dt = 0,6 \text{ A}/\mu\text{s}$	$t_{\text{gd}}$	max. 1,4	$\mu\text{s}$
Freiwerdezeit	circuit commutated turn-off time	siehe Techn.Erl./see Techn. Inf.	$t_{\text{q}}$	S: max. 18 E: max. 20 F: max. 25	$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, 1 min.	$V_{\text{ISOL}}$	3	kV
<b>Thermische Eigenschaften</b>		<b>Thermal properties</b>			
Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	$\Theta = 180^{\circ} \text{ el. sinus: pro Modul/per module}$ pro Zweig/per arm DC: pro Modul/per module pro Zweig/per arm	$R_{\text{thJC}}$	max. 0,115	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
				max. 0,23	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
				max. 0,107	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	pro Modul/per module pro Zweig/per arm	$R_{\text{thCK}}$	max. 0,214	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
				max. 0,03	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
				max. 0,06	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Höchstzul.Sperrschichttemperatur	max. junction temperature		$t_{vj \text{ max}}$	125	$^{\circ}\text{C}$
Betriebstemperatur	operating temperature		$t_{\text{c op}}$	-40...+125	$^{\circ}\text{C}$
Lagertemperatur	storage temperature		$t_{\text{stg}}$	-40...+130	$^{\circ}\text{C}$
<b>Mechanische Eigenschaften</b>		<b>Mechanical properties</b>			
Si-Elemente mit Druckkontakt	Si-pellet with pressure contact			AIN	
Innere Isolation	internal insulation				
Anzugsdrehmomente für mechanische Befestigung	mounting torque	Toleranz/tolerance $\pm 15\%$	M1	6	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse	terminal connection torque	Toleranz/tolerance $+5\%/-10\%$	M2	6	Nm
Gewicht	weight		G	typ. 430	g
Kriechstrecke	creepage distance			14	mm
Schwingfestigkeit	vibration resistance	f = 50 Hz		5 . 9,81	m/s <sup>2</sup>
Maßbild	outline			1	

1) Werte nach DIN 41787 (ohne vorausgehende Kommutierung) / Values according to DIN 41787 (without prior commutation)

2) Unmittelbar nach der Freiwerdezeit / Immediately after circuit commutated turn-off time

Daten der Dioden siehe unter DD 122 S bei  $V_{\text{RRM}} \leq 800 \text{ V}$  und DD 121 S bei  $V_{\text{RRM}} \leq 1000 \text{ V}$

For data of the diode refer to DD 122 S at  $V_{\text{RRM}} \leq 800 \text{ V}$  and DD 121 S at  $V_{\text{RRM}} \leq 1000 \text{ V}$

TT 101 F, TD 101 F, DT 101 F können auch mit gemeinsamer Anode oder gemeinsamer Kathode geliefert werden.

TT 101 F, TD 101 F, DT 101 F can also be supplied with common or common cathode

Recognized by UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

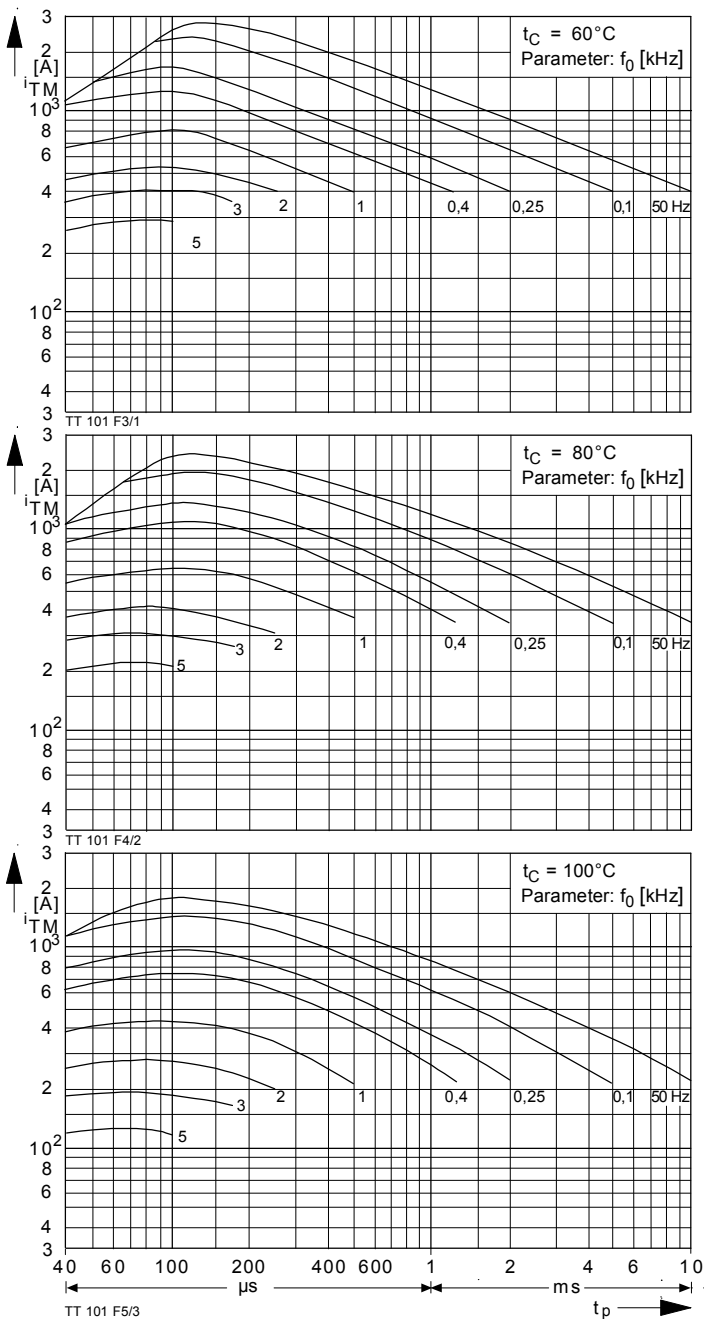
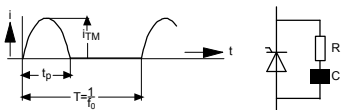


Bild / Fig. 1, 2, 3  
 Höchstzulässige Strombelastbarkeit in Abhängigkeit von der Halbschwingungsdauer für einen Zweig bei: sinusförmigem Stromverlauf, der angegebenen Gehäusetemperatur  $t_c$ , Vorwärts-Sperrspannung  $V_{DM} \leq 0,67 V_{DRM}$ ; Freierzeitzeit  $t_q$  gemäß 5. Kennbuchstaben, Spannungssteilheit  $dv_D/dt$  gemäß 6. Kennbuchstaben.

Ausschaltverlustleistung:  
 - Berücksichtigt für den Betrieb bei  $f_0 = 50 \text{ Hz} \dots 0,4 \text{ kHz}$  für  $dv_R/dt \leq 600 \text{ V}/\mu\text{s}$  und Anstieg auf  $v_{RM} \leq 0,67 V_{RRM}$ ;  
 - nicht Berücksichtigt für Betrieb bei  $f_0 \geq 1 \text{ kHz}$ . Diese Kurven gelten jedoch für den Betrieb mit antiparalleler Diode oder  $dv_R/dt \leq 100 \text{ V}/\mu\text{s}$  und Anstieg auf  $v_{RM} \leq 50 \text{ V}$ .

Maximum allowable current load versus halfwave duration per arm at: sinusoidal current waveform, given case temperature  $t_c$ , forward off-state voltage  $v_{DM} \leq 0,67 V_{DRM}$ , circuit commutated turn-off time  $t_q$  according to 5th code letter, rate of rise of voltage  $dv_D/dt$  according to 6th code letter.

Turn-off losses:  
 - taken into account for operation at  $f_0 = 50 \text{ Hz}$  to  $0,4 \text{ kHz}$  for  $dv_R/dt \leq 600 \text{ V}/\mu\text{s}$  and rise up to  $v_{RM} \leq 0,67 V_{RRM}$ ;  
 - not taken into account for operation at  $f_0 \geq 1 \text{ kHz}$ . But the curves are valid for operation with inverse paralleled diode or  $dv_R/dt \leq 100 \text{ V}/\mu\text{s}$  and rise up to  $v_{RM} \leq 50 \text{ V}$ .



RC-Glied/RC network:  
 $R[\Omega] \geq 0,02 \cdot v_{DM} [V]$   
 $C \leq 0,15 \mu\text{F}$

Parameter: Wiederholfrequenz  $f_0$  [kHz]    Steuergenerator/Pulse generator:  
 Repetition rate  $f_0$  [kHz]     $i_G = 0,6 \text{ A}$ ,  $t_a = 1 \mu\text{s}$

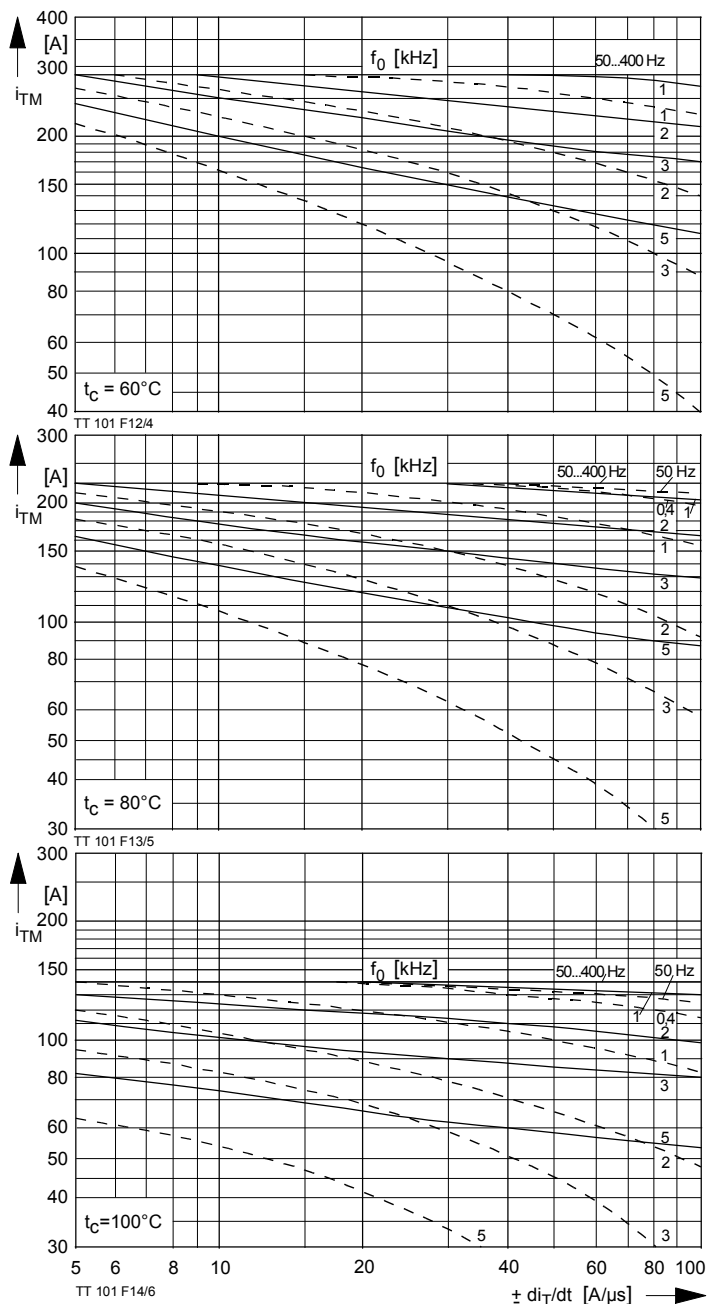
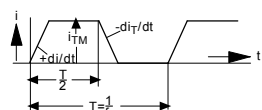


Bild / Fig. 4, 5, 6  
 Höchstzulässige Strombelastbarkeit in Abhängigkeit von der Stromsteilheit für einen Zweig bei: trapezförmigem Stromverlauf, der angegebenen Gehäusetemperatur  $t_c$ ; Vorwärts-Sperrspannung  $v_{DM} \leq 0,67 V_{DRM}$ ; Freierzeitzeit  $t_q$  gemäß 5. Kennbuchstabe, Spannungssteilheit  $dv/dt$  gemäß 6. Kennbuchstabe.

Ausschaltverlustleistung berücksichtigt; die Kurven gelten für:  
 — Betrieb mit antiparalleler Diode oder  $dv_R/dt \leq 100 \text{ V}/\mu\text{s}$  bei Anstieg auf  $v_{RM} \leq 50 \text{ V}$ .  
 - - - -  $dv_R/dt \leq 600 \text{ V}/\mu\text{s}$  und Anstieg auf  $v_{RM} = 0,67 V_{RRM}$ .

Maximum allowable current load versus of rise of current per arm at: trapezoidal current waveform, given case temperature  $t_c$ , forward off-state voltage  $v_{DM} \leq 0,67 V_{DRM}$ , circuit commutated turn-off  $t_q$  according to 5th code letter, rate of rise of voltage  $dv/dt$  according to 6th code letter.

Turn-off losses taken into account; the curves apply for:  
 — Operation with inverse paralleled diode or  $dv_R/dt \leq 100 \text{ V}/\mu\text{s}$  rising up to  $v_{RM} \leq 50 \text{ V}$ .  
 - - - -  $dv_R/dt \leq 600 \text{ V}/\mu\text{s}$  rising up to  $v_{RM} = 0,67 V_{RRM}$ .



RC-Glied/RC network:  
 $R[\Omega] \geq 0,02 \cdot v_{DM} [V]$   
 $C \leq 0,22 \mu\text{F}$

Parameter: Wiederholfrequenz  $f_0$  [kHz]    Steuergenerator/Pulse generator:  
 Repetition rate  $f_0$  [kHz]     $i_G = 0,6 \text{ A}$ ,  $t_a = 1 \mu\text{s}$

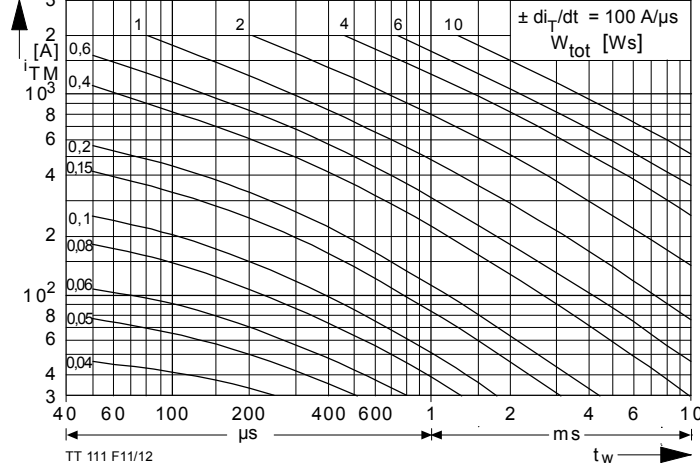
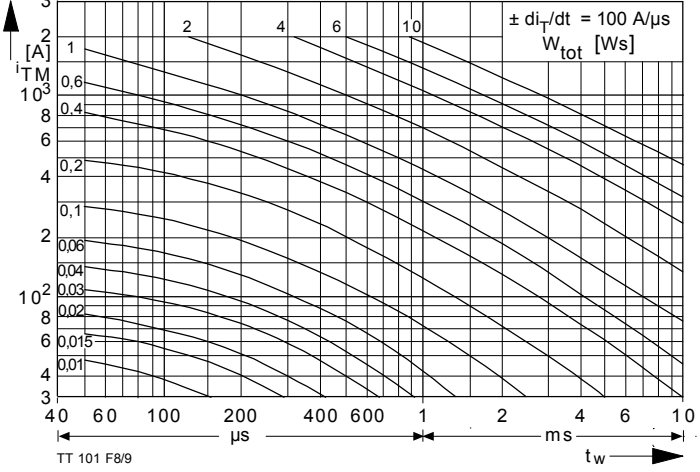
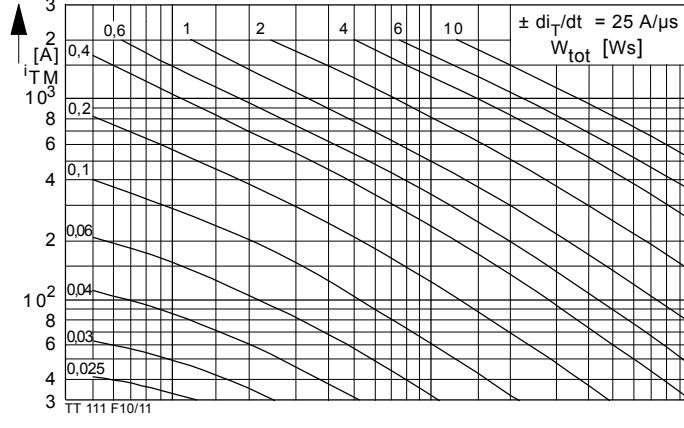
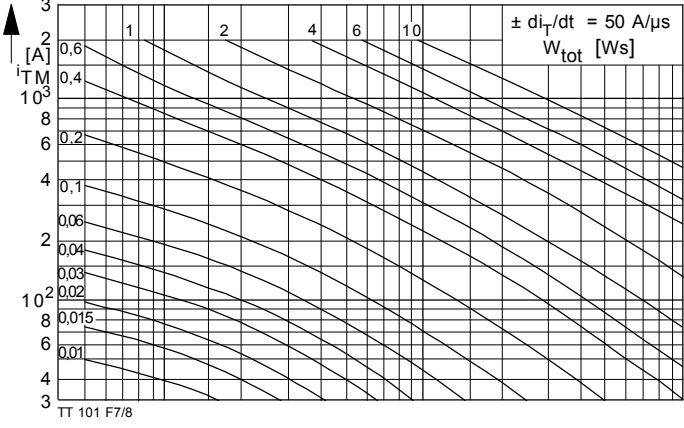
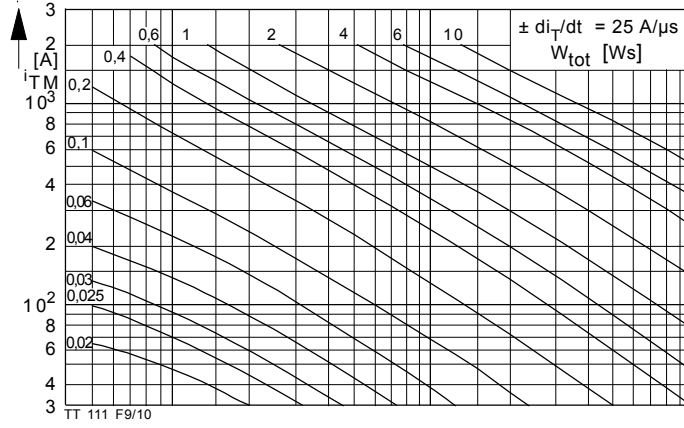
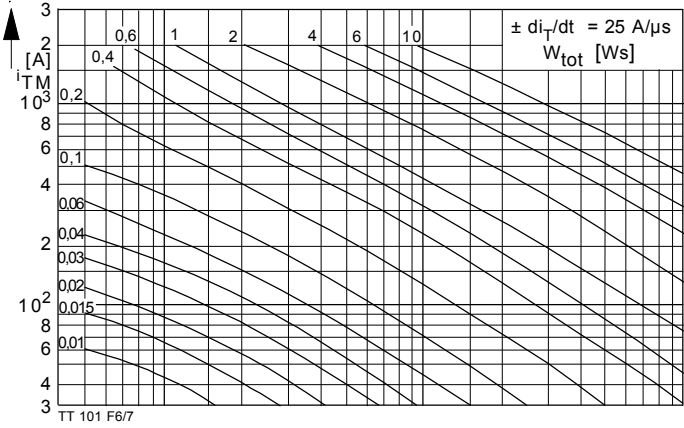


Bild / Fig. 7, 8, 9  
Diagramme zur Ermittlung der Gesamtenergie  $W_{tot}$  für einen trapezförmigen Durchlaß-Strompuls, für einen Zweig bei:  
der angegebenen Stromsteilheit  $di_T/dt$ ,  
Vorwärts-Sperrspannung  $v_{DM} \leq 0,67 V_{DRM}$ ,  
Rückwärts-Sperrspannung  $v_{RM} \leq 50V$ ,  
Spannungssteilheit  $dv_R/dt \leq 100 V/\mu s$ .

Diagram for the determination of the total energy  $W_{tot}$  for a trapezoidal current pulse for one arm at:  
given rate of rise of on-state current  $di_T/dt$ ,  
forward off-state voltage  $v_{DM} \leq 0,67 V_{DRM}$ ,  
maximum reverse voltage  $v_{RM} \leq 50V$ ,  
rate of rise of off-state voltage  $dv_R/dt \leq 100 V/\mu s$ .

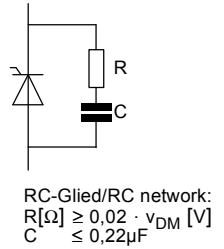
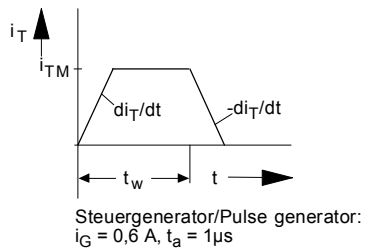
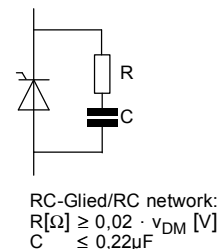
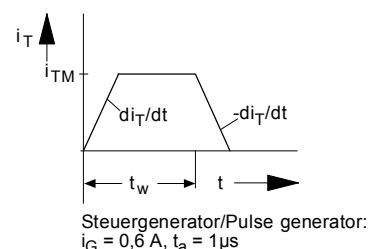


Bild / Fig. 10, 11, 12  
Diagramme zur Ermittlung der Gesamtenergie  $W_{tot}$  für einen trapezförmigen Durchlaß-Strompuls, für einen Zweig bei:  
der angegebenen Stromsteilheit  $di_T/dt$ ,  
Vorwärts-Sperrspannung  $v_{DM} \leq 0,67 V_{DRM}$ ,  
Rückwärts-Sperrspannung  $v_{RM} \leq 0,67 V_{RRM}$ ,  
Spannungssteilheit  $dv_R/dt \leq 500 V/\mu s$ .

Diagram for the determination of the total energy  $W_{tot}$  for a trapezoidal current pulse for one arm at:  
given rate of rise of on-state current  $di_T/dt$ ,  
forward off-state voltage  $v_{DM} \leq 0,67 V_{DRM}$ ,  
maximum reverse voltage  $v_{RM} \leq 0,67 V_{RRM}$ ,  
rate of rise of off-state voltage  $dv_R/dt \leq 500 V/\mu s$ .



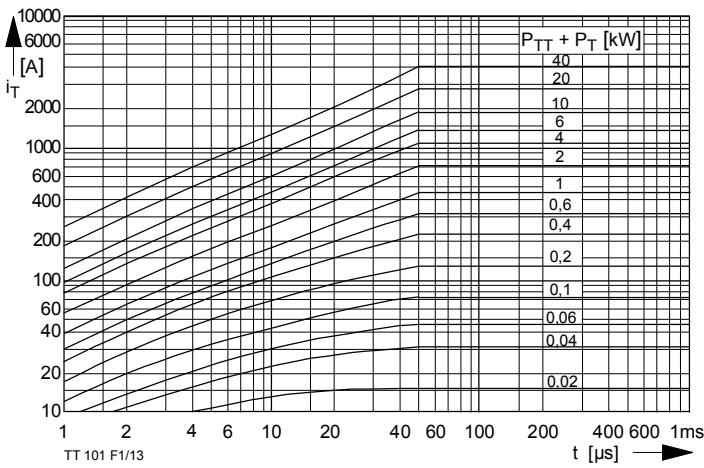


Bild / Fig. 13  
Diagramm zur Ermittlung der Summe aus Einschalt- und Durchlaßverlustleistung ( $P_{TT} + P_T$ ) je Zweig.  
Diagram for the determination of the sum of the turn-on and on-state power loss per arm ( $P_{TT} + P_T$ ).

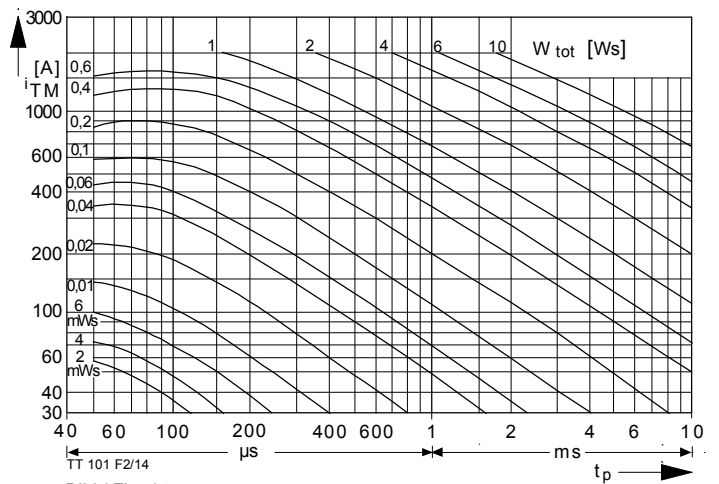
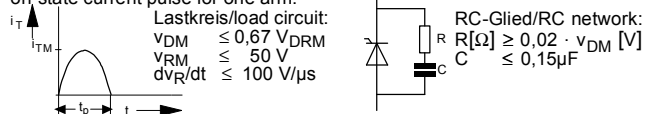


Bild / Fig. 14  
Diagramm zur Ermittlung der Gesamtenergie  $W_{tot}$  für einen sinusförmigen Durchlaß-Strompuls für einen Zweig.  
Diagram for the determination of the total energy  $W_{tot}$  for a sinusoidal on-state current pulse for one arm.



Steuergenerator/Pulse generator:  
 $i_G = 0,6 \text{ A}$ ,  $t_a = 1 \mu\text{s}$

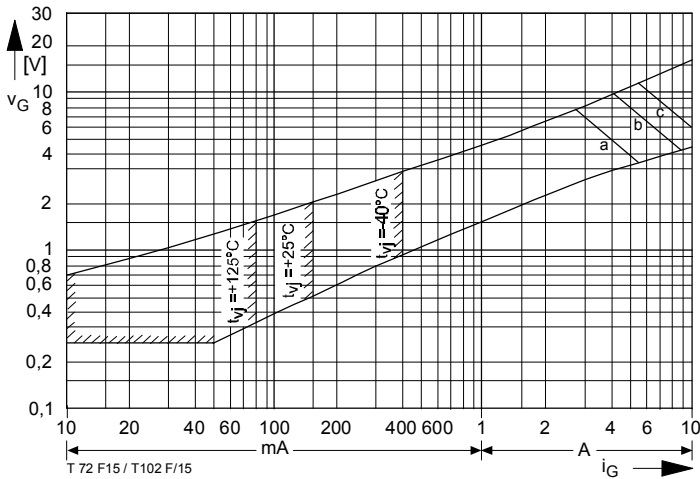


Bild / Fig. 15  
Zündbereich und Spitzensteuerleistung bei  $v_D = 6\text{V}$ .  
Gate characteristic and peak power dissipation at  $v_D = 6\text{V}$ .  
Parameter: a b c

Steuerimpulsdauer/Pulse duration $t_g$	[ms]	10	1	0,5
Höchstzulässige Spitzensteuerleistung/Maximum allowable peak gate power	[W]	20	40	60

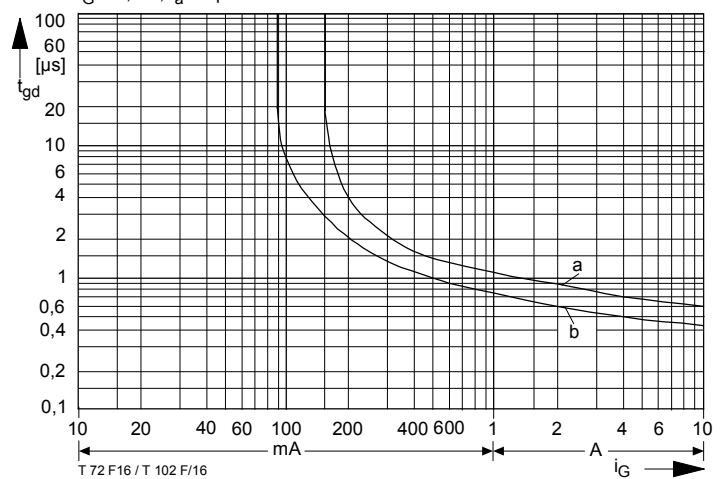


Bild / Fig. 16  
Zündverzögerung/Gate controlled delay time  $t_{gd}$ .  
DIN 41787,  $t_a = 1 \mu\text{s}$ ,  $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ .  
a - äußerster Verlauf/limiting characteristic  
b - typischer Verlauf/typical characteristic

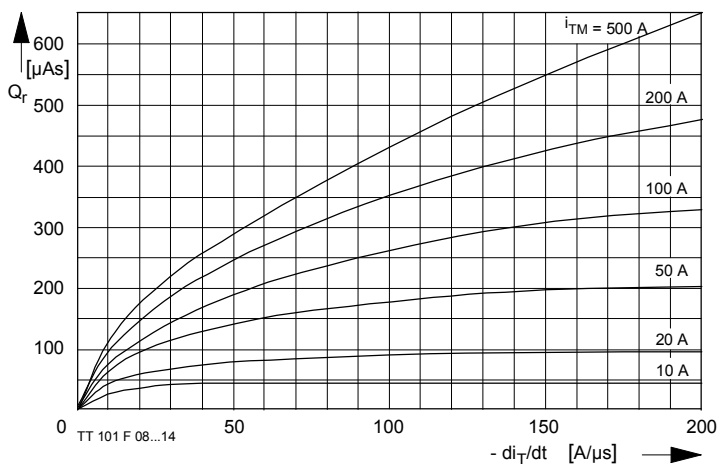


Bild / Fig. 17  
Sperrverzögerungsladung  $Q_r = f(di/dt)$   
 $t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$ ;  $v_R = 0,5 V_{RRM}$ ;  $v_{RM} = 0,8 V_{RRM}$   
Parameter: Durchlaßstrom  $I_{TM}$   
Recoverer charge  $Q_r = f(di/dt)$   
 $t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$ ;  $v_R = 0,5 V_{RRM}$ ;  $v_{RM} = 0,8 V_{RRM}$   
Parameter: on-state current  $I_{TM}$

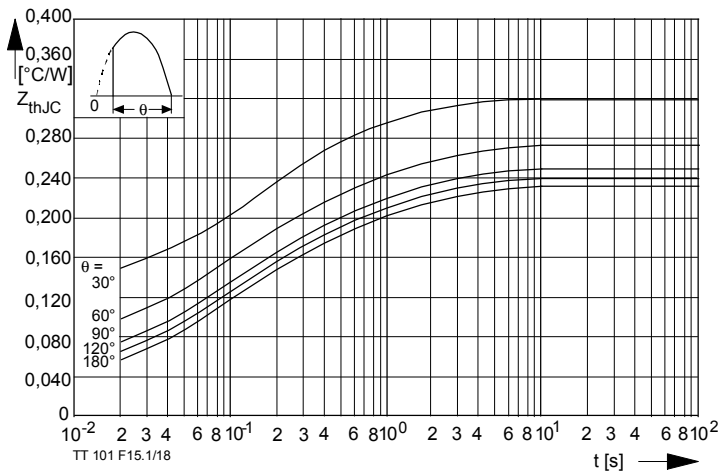


Bild / Fig. 19  
 Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig  $Z_{(th)JC}$ .  
 Transient thermal impedance per arm  $Z_{(th)JC}$ , Junction to case.

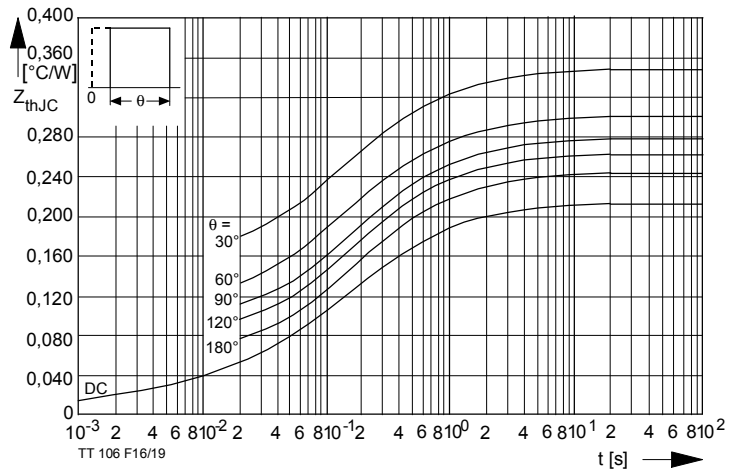


Bild / Fig. 20  
 Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig  $Z_{(th)JC}$ .  
 Transient thermal impedance, junction to case, per arm  $Z_{(th)JC}$ .

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thJC}$  pro Zweig für DC  
 Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thJC}$  per arm for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn} [^{\circ}C/W]$	0,0095	0,025	0,076	0,073	0,0305		
$\tau_n [s]$	0,00089	0,0078	0,086	0,412	2,45		

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$